Searching PAJ Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-308672

(43) Date of publication of application: 23.10.2002

(51)Int.Cl.

CO4B 35/49 H01L 41/083 H01L 41/09 H01L 41/107

H01L 41/187

H01L 41/24

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

29.11.2001

(72)Inventor: NADA KENICHI

OKADA KAZUNARI

KIDA MASATAKA

(30)Priority

Priority number : 2001032862

(21)Application number: 2001-364272

Priority date : 08.02.2001

Priority country: JP

# (54) METHOD FOR MANUFACTURING PIEZOELECTRIC CERAMIC, PIEZOELECTRIC CERAMIC AND PIEZOELECTRIC CERAMIC DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing piezoelectric ceramics so that the calcination temperature can be suppressed low by using a solid phase method. SOLUTION: In the method for manufacturing piezoelectric ceramics, lead titanate zirconate piezoelectric ceramics are obtained by synthesizing a piezoelectric ceramic material containing lead oxide powder, zirconium oxide powder and titanium oxide powder. In this method, a part of the lead oxide powder and the titanium oxide powder are mainly made to react to obtain lead titanate, and then the lead oxide powder not used for the above reaction. the zirconium oxide powder and the lead titanate are made to react to obtain the lead titanate zirconate

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.10.2003

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-308672 (P2002-308672A)

最終頁に続く

				(43)公	平 日開	成14年10月25	日 (2002. 10. 23)
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			;	7.3}*(参考)
C 0 4 B	35/49		C 0 4 B	35/49		A	4G031
						Q	
						R	
H01L			H01L	41/22		A	
	41/09			41/18		101D	
		審査請求	未請求 請求	関の数	8 OL	(全 13 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-364272(P2001-364272)	(71)出職	J 0000	06231		
				株式	会社村田	製作所	
(22)出順日		平成13年11月29日(2001.11.29)	京都府長岡京市天神二丁目26番			26番10号	
			(72)発明:	者 雅	研一		
(31)優先権主張番号				京都	府長岡京	市天神二丁目	26番10号 株式
(32)優先日		平成13年2月8日(2001.2.8)		会社	村田製作	所内	
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(72)発明	者 岡田	一成		
				京都	府長岡京	市天神二丁目	26番10号 株式
				会社	村田製作	所内	
			(72)発明	者 木田	雅隆		
					府長岡京 村田製作	市天神二丁目 所内	26番10号 株式
			1				

(54) 【発明の名称】 圧電セラミックの製造方法、圧電セラミック、および圧電セラミック素子

## (57)【要約】

【課題】 固相法を用いて、かつ焼成温度を低く抑える ととができる圧電セラミックの製造方法を提供する。 に解決手段】 酸化鉛粉末、酸化シルコニウム粉末、お よび酸化チタン粉末を含む圧電セラミック材料を合成し でチタン酸シルコン酸鉛系圧電セラミックを得る圧電セ ラミックの製造方法であって、主として、前記酸化鉛粉 末の一部と前記酸化チタン粉末とを反応させてチタン酸 動と得た後、未反応の前記酸化鉛粉末と前記酸化シルコ ニウム粉末と前記形々ン酸砂・ ルコン酸粉を得る。

## 【特許請求の節用】

【請求項1】 酸化鉛粉末、酸化ジルコニウム粉末、お よび酸化チタン粉末を含む圧電セラミック材料を合成し てチタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミックを得る圧電セ ラミックの製造方法であって

1

主として、前記酸化鉛粉末の一部と前記酸化チタン粉末 とを反応させてチタン酸鉛を得た後、未反応の前記酸化 鉛粉末と前記酸化ジルコニウム粉末と前記チタン酸鉛と を反応させてチタン酸ジルコン酸鉛を得ることを特徴と する圧電セラミックの製造方法。

【請求項2】 酸化鉛粉末と酸化チタン粉末とを反応さ せてチタン酸鉛を得る工程と、

前記チタン酸鉛と酸化鉛粉末と酸化ジルコニウム粉末と を混合し、反応させてチタン酸ジルコン酸鉛を得る工程 と、を含むことを特徴とする圧電セラミックの製造方 法。

【請求項3】 前記圧電セラミック材料のうち 酸化 ジルコニウム粉末の比表面積をx(m²/g)、酸化チ タン粉末の比表面積をy(m²/g)としたとき、

y≥1. 218 e\*.117x (ただし、x≥1) を満たすことを特徴とする請求項1に記載の圧電セラミ ックの製造方法。

【贈求項4】 前記チタン酸鉛を得る工程、または前 記チタン酸ジルコン酸鉛を得る工程の少なくともいずれ か一方に酸化ニオブ粉末を添加して反応させることを特 徴とする請求項2に記載の圧電セラミックの製造方法。 前記圧電セラミック材料に酵化ニオブ 粉末が含まれることを特徴とする請求項3に記載の圧電 セラミックの製造方法。

【請求項6】 粉砕後の前記圧電セラミック材料の比 30 表面積が、粉砕前の前記圧電セラミック材料の比表面積 の1. 4倍以上になるように、前記圧電セラミック材料 を粉砕することを特徴とする請求項1または請求項3に 記載の圧電セラミックの製造方法。

【請求項7】 請求項1から請求項6のいずれかに記 載の圧電セラミックの製造方法によって得られた、圧電 セラミック。

[請求項8] 請求項7に記載の圧電セラミックに. 電極を形成してなることを特徴とする圧電セラミック素 子。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は圧電セラミック 特 にチタン酸ジルコン酸鉛を主成分とする圧電セラミック の製造方法、および、それによって得られた圧電セラミ ック、ならびに圧電セラミック素子に関する。

### [00021

[従来の技術および発明が解決しようとする課題] 従来 より、アクチュエータやトランスなどの電子部品には、

分とする圧電セラミックが用いられている。一般に、こ のチタン酸ジルコン酸鉛を合成するにあたっては、出発 原料として、酸化鉛 (PbO) 粉末、酸化ジルコニウム (ZrO。)粉末、および酸化チタン (TiO、)粉末を 秤量して混合・粉砕した後、熱処理を行うという固相法 が採られている。熱処理時には、まず約500℃から、 酸化鉛と酸化チタンが反応してチタン酸鉛(PbTiO が生成され、次いでチタン酸鉛の生成途中である約 600~700°Cから、ジルコン酸鉛(PhZrO.) 10 が生成される。そして、約800~1000℃から、と のチタン酸鉛とジルコン酸鉛が反応して、チタン酸ジル コン酸鉛 (Pb(Zr, Ti)O,) が得られている。 【0003】しかしながら、出発原料を混合し、熱処理 する固相反応おいて、ジルコン酸鉛とチタン酸鉛とを反 応させて、均一な結晶構造を有するチタン酸ジルコン酸

鉛を得るためには、生成されたジルコン酸鉛を固溶させ てチタン酸鉛と反応させる必要がある。したがって、一 旦ジルコン酸鉛の生成が開始されてしまうと、ジルコン 酸鉛の生成・固溶温度が高いために、結果的にチタン酸 20 ジルコン酸鉛を得るための合成温度が上昇することにな り、得られるチタン酸ジルコン酸鉛粒子の粒成長を促し て粒子の粗大化が生じる。このため、チタン酸ジルコン 酸鉛粒子の反応性が低下し、焼結温度が上昇してしま う。また、焼結温度が上昇することにより、チタン酸ジ ルコン酸鉛の焼成時に鉛成分の一部が揮発し、組成比ず れを生じてしまう。

【0004】そこで、チタン酸ジルコン酸鉛の低温機結 を目的として、特開平5-306122号には、鉛以外 の構成元素のアルコキシドを加水分解して得られた単分 散状複合酸化物の微粉末に鉛酸化物の粉末を添加混合 し、熱処理することによって、中間化合物を生じること なく、直接チタン酸ジルコン酸鉛を得ることができると いう技術が開示されている。

【0005】しかしながら、出発原料にアルコキシドを 用いるという方法は、工程が煩雑になって手間がかかる うえ、出発原料自体のコストも高く、量産には向かない という問題点がある。そこで、固相法を用いて、かつ焼 成温度を低く抑えることができる圧電セラミックの製造 方法が求められている。

## 40 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記のような問 題点に鑑みてなされたものである。本願第1の発明の圧 電セラミックの製造方法は、酸化鉛粉末、酸化ジルコニ ウム粉末、および酸化チタン粉末を含む圧電セラミック 材料を合成してチタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミック を得る圧電セラミックの製造方法であって、 すとして 前記酸化鉛粉末の一部と前記酸化チタン粉末とを反応さ せてチタン酸鉛を得た後、未反応の前記酸化鉛粉末と前 記酸化ジルコニウム粉末と前記チタン酸鉛とを反応させ 電気機械結合係数が大きいチタン酸ジルコン酸鉛を主成 50 てチタン概ジルコン酸鉛を得ることを特徴とする。

【0007】また、本願第2の発明の圧電セラミックの 製造方法は、酸化鉛粉末と酸化チタン粉末とを反応させ てチタン酸鉛を得る工程と、前記チタン酸鉛と酸化鉛粉 末と酸化ジルコニウム粉末とを混合し、反応させてチタ ン酸ジルコン酸鉛を得る工程とからなることを特徴とす

【0008】このような製造方法にすることにより、チ タン酸ジルコン酸鉛を合成する過程において、高温で熱 処理する必要があるジルコン酸鉛の生成を抑制すること ができ、圧電セラミックを得るのに必要な熱処理温度を 10 低く抑えることができる。さらに、上記のような製造方 法によって得られるチタン酸ジルコン酸鉛は、反応性が 向上されており、圧電セラミックとしたときの粒界に存 在する未反応の酸化鉛を低減できることを本発明者らは 見出した。

【0009】また、本願第3の発明の圧電セラミックの 製造方法は、前記圧電セラミックの材料のうち、酸化ジ ルコニウム粉末の比表面積をx(m²/g)、前記酸化 チタン粉末の比表面積をy(m²/g)としたとき、

y≥1. 218 e°·117x (ただし、x≥1) を満たすことが好ましい。

【0010】酸化チタン粉末および酸化ジルコニウム粉 末の比表面積をこのような関係にすることによって、通 常の粉砕、混合レベルで、鉛に対する酸化チタン粉末の 反応性を、鉛に対する酸化ジルコニウム粉末の反応性に 比べて相対的に高くすることができるので、PbO、T iOz, およびZrOzを同時に合成しても、ジルコン酸 鉛の生成を抑制することができる。すなわち、まずチタ ン酸鉛が合成され、次にジルコン酸鉛の生成が始まる前 にチタン酸ジルコン酸鉛の生成が開始されるため、結果 30 的にジルコン酸鉛の生成が抑制されるのである。

【0011】また、本願第4の発明の圧電セラミックの 製造方法は、前記チタン酸鉛を得る工程、または前記チ タン酸ジルコン酸鉛の得る工程の少なくともいずれか-方に酸化ニオブ粉末を添加して反応させることが好まし

【0012】さらに、本願第5の発明の圧電セラミック の製造方法は、前記圧電セラミック材料に酸化ニオブ粉 末を含まれることが好ましい。

【0013】上記のような製造方法にすることによっ て、圧電セラミックを得るのに必要な熱処理温度を低く し、圧電セラミックとしたときの粒界に存在する未反応 の酸化鉛を低減できるのに加え、圧電特性に優れた、特 に電気機械結合係数、機械的品質係数、キュリー点の高 い圧電セラミックを得ることができる。

【0014】また、鉛元素を含有する圧電セラミック中 にニオブ元素が含まれる場合、Bサイト元素をあらかじ め仮焼しておくといった特殊な製造方法を用いる場合を 除き、仮焼時に出発原料の鉛元素とニオブ元素とが選択 ような製造方法をすることによって、このパイロクロア 相による圧電セラミックへの悪影響もなくすことができ る。以下、その理由について説明する。バイロクロア相 とチタン酸ジルコン酸鉛のペロブスカイト相とが混在す る仮焼粉末を成形して、焼成した場合、パイロクロア相 とペロプスカイト相との収縮率が異なるため焼結体にク ラックが生じる恐れがある。しかし、上記のような製造 方法にすることにより、ペロブスカイト相が生成される 温度に達するまでに、パイロクロア相を問題ないレベル まで消滅させ、バイロクロア相とペロプスカイト相とが 混在することを防ぐことができる。その結果、焼結体の 外観にクラックを生じない緻密な圧電セラミックを得る ととができる.

【0015】また、本願第6の発明の圧電セラミックの 製造方法においては、粉砕後の前記圧電セラミック材料 の比表面積が、粉砕前の前記圧電セラミック材料の比表 面積の1. 4倍以上になるように、前記圧電セラミック 材料を粉砕することが好ましい。

【0016】とのような比表面積になるまで圧電セラミ 20 ック材料を粉砕することによって、チタン酸ジルコン酸 鉛を合成する際、PbO、TiO、およびZrO、を同 時に合成しても、ジルコン酸鉛の生成を抑制することが できる。すなわち、出発原料である酸化チタン粉末、酸 化ジルコニウム粉末が本願第3の発明のような範囲にな くても、これらを混合した圧電セラミック材料の比表面 精が上記のようになるまで粉砕するととによって ジル コン酸鉛の生成が抑制できるものである。これは、酸化 チタン粉末が酸化ジルコニウム粉末に比べて粉砕されや すいため、圧電セラミック材料の比表面積を上記のよう な範囲になるまで粉砕することによって、結果的に酸化 チタン粉末と酸化ジルコニウム粉末との間に反応性の差 が生じているためと考えられる。

【0017】また、本願第7の発明の圧電セラミック は、第1の発明から第6の発明のいずれかに記載の圧電 セラミックの製造方法によって得られることを特徴とす る.

[0018]また、本願第8の発明の圧電セラミック素 子は、第7の発明に記載の圧電セラミックに、電極を形 成してなることを特徴とする。

40 【0019】このような製造方法によって得られた圧電 セラミックは、未反応のPb成分が少なく、圧電セラミ ック素子としたときの圧電特性を大幅に向上させること ができる。また、上記圧電セラミックを用いた圧電セラ ミック素子は、その圧電セラミック素子に応じた圧電特 性の大幅な向上を図ることができる。

### [0020]

【発明の実施の形態】本発明の圧電セラミックの製造方 法は、酸化鉛粉末と、酸化チタン粉末と、酸化ジルコニ ウム粉末とを含む圧電セラミック材料から、チタン酸ジ 的に反応を起こし、バイロクロア相を生じるが、上記の 50 ルコン酸鉛を合成するにあたり、主として酸化鉛粉末と

酸化チタン粉末もを合成してチタン酸鉛を合成し、チタン酸鉛と酸化鉛粉末と酸化ジルコニウム粉末とを合成するという反応過程にすることによって、チタン酸シルコン酸鉛が合成されるまでにジルコン酸鉛の生成は不全に抑制したものである。なお、シルコン酸鉛の生成は不全に抑制しなければならないというものではなく、若干量とはチタン酸ジルコン酸鉛の合成過程中に、XF型と手を対象シルコン酸鉛のXRDビーク強度と手の地質とチタン酸シルコン酸鉛のXRDビーク強度とそ同時に制定した場合、ジルコ 10世鉛のXRDビーク強度がチタン酸ジルコン酸鉛のXRDビーク強度がチタン酸ジルコである。

【0021]とでで、出発順料としての酸化総粉末はPD、Pb、O、等が挙げられるが、特に限定はしない。また、酸化デタン粉末はどのようなものを用しても構わないが、圧電セラミックとしたときの圧電物性が低下する恐れがあるため、その比表面積が5m²/g以上のものが好ましく、出発原料として酸化ジルコニウム粉末より反応性の高いものを用いることがまましい。また、酸化ジル 20コニウム粉末はどのようなものを用いても構わないが、圧電セラミックとしたときの圧電物性が低下する恐れがあるため、その比表面積が1m²/g以上のものが好ましく、出発順料として酸化ジルコニウム粉末を同時に添加する場合は、酸化デッコニウム粉末を同時に添加する場合は、酸化デッコーンの分析末を同時に添加する場合は、酸化デッコーンの分析末を同時に添加する場合は、酸化デッン粉末より反応性の低いものを用いることが好ましい。

[0022]また、本発明の圧電セラミックの製造方法 においては、出発原料として酸化ジルコニウムを同時化 窓加する場合は、出発原料を修じチンシ粉末とい で加まる場合は、出発原料を修作チンシ粉末とい い、これらを含む圧電セラミック材料の粉砕前の比表面 横を踏準とし、この基準は分化・砂幹後の圧電セラミック材料の比表面構が1、4倍以上となるようなしてもよ い。なお、ことでいう比表面積の理論値とは以下の式に よって算出したものを指す。

圧電セラミック材料の比表面積 (酸化給粉末の比表面 積×重量比) + (酸化チタン粉末の比表面積×重量比) + (酸化ジルコニウム粉末の比表面積×重量比) + (そ の他の出発原料の比表面積×重量比)

また、本泉明の圧電セラミックの製造方法において、酸 40 化ジルコニウム粉末を出発原料として他の原料粉末と同 時添加する場合に限り、仮焼工程と焼成工程を連続して 行ってもよい。その場合には、圧電セラミック材料にあ ちかじめバインダーを添加しておき、所望の形状に成形 して熱処理することになる。

[0023]また、本発明の圧電セラミックの製造方法は、2成分系のPb(Zr, Ti)の,系の圧電セラミックだけに限らず、複合ペロブスカイト型酸化物を書かる域は、といる過期である。このような3成分系の圧電セラミックにも適用することができる。このような3成分系の圧電セラミッ55を

クとしては、例えば、Pb (Mn, n Sb, n) (Zr, Ti)O, 系 Pb (Co, n W, n) (Zr, Ti)O, 系等が挙げられるが、特にこれら限定されるものではない。また、必要に応じてPbの一部をSr, Ba, La, C 等を添加してもよい。また、N bは終加物として添加してもよい。また、N bは終加物として添加してもよい。大 N b (n N b n, n) (Zr, Ti)O, 系、Pb (M n, n N b n, n) (Zr, Ti)O, 系、Pb (M n, n) (Zr, Ti)O, 系、Pb (Co, n, n N b, n) (Zr, Ti)O, 系 (

圧電セラミックとなる。 【0024】次に、本発明の圧電セラミックの製造方法

【UU24】次に、本発明の圧電セラミックの製造方法 を実施例を用いてさらに具体的に説明する。 【0025】

【実施例】 (実施例1) 本実施例は請求項1に対応する ものである。まず、出発原料として、Pb,O。(比表面 横: 2 m²/g)、TiO,(比表面積: 2 1 m²/ g)、ZrO,(比表面積: 2 4 m²/g)、Cr,O ,(比表面積: 10 m²/g) みを粉末を

20 Pb., n (Zr., n Ti., n)O,+1. 0 mo)%Cr.O, となるよりに秤量し、ボールミルで粉砕、混合を行い、圧電セラミック材料とした。このときの圧電セラミック材料の比表面限は10 m²/gであった。得られた圧電セラミック材料の比表面限は10 m²/gであった。得られた圧燃セラミック材料を昇温速度2°C/minで昇温し、800°C・2時間保持して仮焼し、粉砕して得られた仮焼粉末にパインダーを添加して遊粒した。次に、一辺が15 mmで内厚が1 mmの正方板に成形した後、焼成して焼結体を得た。 さらに、得られた焼結体に分極用電極を形成し、60°Cの絶縁オイル中3000 Vで60分間分極処30 理をし、任電セラミックとした。

【0028】ことで、上版のようにして得られた圧電セラミックの奴隷時に起こる反応と、生成される化合物を調べるためた、上記組成の試料を複数用意と、所定の温度まで昇温した時点でその過程を3分間保料して、その試料のXRDビーク強度比を測定した。その結果を図1 に示す。なお、各試料の仮集においては、保持する仮集組度以外はすべて同じ条件で実験を行った。また、比較例として、下10.粉末(比表面積:5 m²/g²)、Zr O.粉末(比表面積:2 4 m²/g²)とした以外は上配方法と同様にしてXRDビーク強度比を測定したものを図2に示す。

【002/7】また、上記圧電セラミックを得るにあたり、焼成温度を変動させ、それぞれの温度で3時間焼成したときの焼結密度および電気機械結合係数を測定し、それぞれ図3、図4に示した。

(実施例2) 本実施例は請求項2に対応するものである。まず、Pb,O,(比表面積:2m²/g)、TiO,(比表面積:5m²/g)、ZrO,(比表面積:24m²/g)、Cr,O,(比表面積:10m²/g)の名粉末

Pb1.00(Zr0.49Ti0.51)O1+1. 0mo1%Cr,O1 となるように秤量した。このうち、ZгО,を除く粉末 を出発原料としてボールミルで粉砕、混合して混合物と し、この混合物を昇温速度2°C/minで昇温し、70 0°Cで2時間保持して仮焼し、未反応の酸化鉛を含むP bTiO,を合成した。次いで、この未反応の酸化鉛を 含むPbTiO,を粉砕し、ZrO,粉末を加えて昇温速 度2℃/minで昇温し、900℃で2時間保持して再 度仮焼し、粉砕して得られた仮焼粉末にバインダーを添 加して造粒した。次に、一辺が15mmで肉厚が1mmの下 10 方板に成形した後、焼成して焼結体を得た。さらに、得 られた焼結体に分極用電極を形成し、60℃の絶縁オイ ル中3000Vで60分間分極処理をし、圧電セラミッ クとした。

【0028】ここで、実施例1と同様に、焼結密度およ び電気機械結合係数を測定し、それぞれ図3、図4に示

【0029】(実施例3)本実施例は請求項3および請 求項7に対応するものである。実施例1と同様の組成の 圧電セラミックにおいて、酸化チタン粉末と酸化ジルコ 20 ニウム粉末の比表面積xと酸化チタン粉末の比表面積y ニウム粉末の比表面積を変動させた。この酸化チタン粉 末と酸化ジルコニウム粉末とを用いて、チタン酸ジルコ ン酸鉛を合成する過程におけるジルコン酸鉛の生成の有 無を調べ、さらに得られた圧電セラミックの電気機械結 合係数を測定した。なお、チタン酸ジルコン酸鉛を合成 する過程におけるジルコン酸鉛の生成の有無の確認方 法、および圧電セラミックの製造方法については実施例 1と同様とした。その結果を表1および図5に示す。ま た、本発明の範囲外となる試料については、表1中では \*印、図5中では×印で示している。なお、参考のため 30 ウム粉末の比表面積xと酸化チタン粉末の比表面積yと 実施例1において作製した比較例についても表1に示し ている。

[0030]

【表1】

試包書品		界の	PbZrO <sub>3</sub>	燥成	電気機械	
政科書号	比表面積(m²/g)		の生成	温度	結合係數	
	ZrO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>		(°C)	(%)	
1	1	5	*	1150	36	
2	12	21	無	1150	37	
3	12	5	無	1150	38	
4	12	52	無	1150	40	
5	12	78	*	1150	42	
6	12	111	*	1150	43	
*7	24	5	*	1150	30	
8	24	21	*	1150	39	
9	24	52	無	1150	42	
10	24	78	無	1150	43	
- 11	24	_111	#	1150	44	
* 12	32	21	有	1150	32	
13	32	52	無	1150	44	
14	32	78	*	1150	45	
15	32	111	無	1150	46	
* 16	38	52	4	1150	33	
17	38	_111	無	1150	46	
* 18	50	21	Ť	1150	29	
* 19	50	52	有	1150	31	
* 20	50	78	*	1150	32	
<b>* 21</b>	50	111	*	1150	34	
比較例	24	5	*	1250	37	
比較衡	24	5	有	1100	25	

【0031】表1および図5に示すように、酸化ジルコ との関係がy≥1,218 e°.117xかつ。x≥1の範囲 にあるものは、酸化チタン粉末と、酸化ジルコニウム粉 末とを出発原料として同時に添加し、仮焼しても、チタ ン酸ジルコン酸鉛を合成する過程において、ジルコン酸 鉛が生成していないことがわかる。また、上記範囲にあ る酸化チタン粉末および酸化ジルコニウム粉末を用いて 作製した圧電セラミックは、その焼成温度を低減できる ことがわかる。

【0032】ここで、請求項3において、酸化ジルコニ の関係をy≥1,218e°.117xかつ、x≥1に限定し た理由を説明する。請求項3において、y≥1.218 eº.117xとしたのは、試料番号7, 12, 16, 18~ 21のように、酸化チタン粉末の比表面積と酸化ジルコ ニウム粉末の比表面積との関係が、図4におけるy= 1. 218 e 0.117x を示すグラフの右下側の領域に位置 する (y<1.218 e°·117x) 場合は、チタン酸ジル コン酸鉛を合成する過程において、ジルコン酸鉛が生成 され、圧電セラミックの焼成温度が高く好ましくないか 40 らである。

[0033]また、x≥1としたのは、y≥1.218 e<sup>0.117×</sup>の範囲内にあっても、x<Iの場合は、出発原 料である酸化ジルコニウム粉末、が粗粒のためチタン酸 ジルコン酸鉛の合成が阻害され、好ましくないからであ

【0034】(実施例4)本実施例は請求項4に対応す るものである。まず、Pb,O,(比表面積:2m²/ g) Ti O2 (比表面積: 5 m²/g)、ZrO2 (比表 面積:24 m²/g)、Nb,O,(比表面積:5 m²/ 50 g) Mn (O<sub>3</sub> (比表面積:20m²/g) の各粉末を用 意した。これらの原料を、

Pb1.00 ((Mn1/3 Nb2/1)0.10 Zr0.49 Tio.41)O, となるように秤量した。このうち、Zr〇ҳを除く粉末 を出発原料としてボールミルで粉砕、混合して混合物と した。この混合物を昇温速度2℃/minで昇温し、7 00℃で2時間保持して仮焼した。このとき、酸化鉛の 一部は反応せずに残っている。次に、未反応の酸化鉛を 含むPbTiO,を粉砕し、ZrO,を加えて昇温速度2 °C/minで昇温し、900°Cで2時間保持して再度仮 焼した後、粉砕して仮焼粉末を得た。次にこの仮焼粉末 10 にバインダーを添加して造粒し、一辺が15mmで肉厚 が1mmの正方形にプレス成形した後、焼成して焼結体 を得た。さらに、得られた焼結体に分極用電極を形成 し、60℃の絶縁オイル中3000∨で60分間分極処 理をし、圧電セラミックとした(試料23)。また、Z rO<sub>2</sub>の比表面積を24m²/g、TiO<sub>2</sub>の比表面積を 21m<sup>2</sup>/gとした以外、上記と同様の方法で作製した 圧電セラミックを作製した(試料24)。

【0035】一方、出発原料および組成を試料23と同 じにし、これを全て一度にボールミルで粉砕し、混合し 20 て混合物とした。この混合物を昇温速度2°C/minで 昇温し、900℃で2時間保持して仮焼し、粉砕して得米

\* られた仮焼粉末にバインダーを添加して造粒したこと以 外は試料23と同様にして圧電セラミックを作製し比較 例1とした。また、Pb,O, TiO, ZrO,以外の 原料として、MnCO,とNb,O,とを含む場合以外 に、Mg (OH), (比表面積: 20m2/g) とNb,O, (比表面積:5 m²/g)とを含む場合(試料25) CoCO。(比表面積:100m2/g)とNb,O,(比 表面積: 5 m²/g) とを含む場合(試料26)、及び N b 2 O, (比表面積: 5 m2/g) のみを含む場合(試 料27)のそれぞれについて、表2に示す組成式を満た すように秤量し、それ以外は試料23と同様の方法で圧 電セラミックを作製した。また、実施例2で作製したN bを含まない試料を比較例2とした。

10

【0036】ここで、試料23~27、比較例1及び比 較例2の圧電セラミックの焼成温度を1100℃とし、 3時間焼成したときの焼結密度、及び電気機械結合係数 (Kp)を測定した。さらに、圧電セラミック素子の焼 結体におけるクラック発生有無を目視により観察した。 その結果を表2に示す。

[0037] [表2]

製料 番号	模技术	出党 比表面 Z-O	TIO	か(ロカロア相 の演練温度 (*C)	機成 温度 (fc)	競精 樹皮	電気機能 総合係条 (%)	競技体のクラック 発生有無 (1000℃で仮像)
23	Physi(Odt: aNto-alauZranThas)O.	94	6	1000	1100	7.83	40	C.O.O.O.C.B.G.
24	Physiothy Marshan Zran Than O	24	21	1000	1100	7.96	4	
25	Physicong phonon of Part Tan Co	24	- 6	900	1100	7.82	45	
26	PhysillCom/MozakinZragiTaniO	24	- 6	\$50	1100	7.85	51	-
21	Pour (ZrassTiggs)Os+0.06moiNb	24	- 6	950	1100	7.87	62	
比較例	Pour(OdnyNbys)assZrenTless)Cs	24_	- 5	1150	1100	7.63	35	*
比較例	PhysiCzest Teas Cy 0.00molMn	24	-		1100	7.83	32	

[0038]試料23~27ともに、Nhを含まない比 較例2よりも電気機械結合係数 (Kp) が優れているこ とがわかる。また、Nbを含む場合でも請求項2を満た す試料23~27についてはパイロクロア相が問題ない レベルに消滅する温度が低く、ペロブスカイト相の生成 時に実質的にパイロクロア相が存在していないため、焼 結体にクラックが発生していないことがわかる。このた め、焼成温度が1100℃と低い場合でもバイロクロア 相とペロブスカイト相とが実質的に混在していないため 高い焼結密度を保ち、電気機械結合係数(KD)も高い ことがわかる。一方、Nbを含むが請求項2の範囲外で ある比較例1についてはバイロクロア相が問題ないレベ 40 ルにまで消滅する温度が高く、焼結する際にパイロクロ ア相とペロブスカイト相とが実質的に混在しているた め、焼結密度及び電気機械結合係数 (Kp) が試料23 ~27よりも劣り、焼結体にクラックが発生している。 【0039】(実施例5)本実施例は請求項5に対応す るものである。まず、出発原料としてTiO,(比表面 積:21m²/g)、ZrO2(比表面積:24m²/ g)、Pb,O,(比表面積:2m²/g)、Nb,O ;(比表面積:5 m²/g), Cr,O,(比表面積:10 m²/g) の各粉末をPb:..。{(Cr:/, Nb:/, )O。 50 【004 1】図6に示す実施例においては、Pb ZrO

Tio.49 Zro.48) Oaとなるように秤量し、ボールミ 30 ルで粉砕、混合を行い、圧電セラミック材料とした。と の時の圧電セラミック材料の比表面積は10 m²/gで あった。得られた圧電セラミック材料を昇温速度2℃/ minで昇温し、900℃で2時間保持して仮焼し、粉 砕して得られた仮焼粉末にバインダーを添加して造粒し た。次に一辺が15mmで肉厚が1mmの正方板に成形 した後、焼成して焼結体を得た。さらに、得られた焼結 体に分極用電極を形成し、60°Cの絶縁オイル中300 0 Vで6 0 分間分極処理をし、圧電セラミックとした。 【0040】ととで上記のようにして得られた圧電セラ ミックの仮焼時に起こる反応と、生成される化合物を調 べるために、上記組成の試料を複数用意し、所定の温度 まで昇温した時点でその温度を3分間保持して、その試 料のXRDビーク強度比を測定した。その結果を図6に 示す。なお、各試料においては、保持する仮焼温度以外 は全て同じ条件で実験を行った。また、比較例として、 請求項5の範囲外であるTiO、粉末(比表面積:5 m<sup>2</sup> /g)、ZrOz粉末 (比表面積:24m²/g) とした 以外は上記方法と同様にしてXRDピーク強度比を測定 したものを図7に示す。

,が若干生成されるが、問題ない程度にしか発生してい ないため、低温からPZTが生成されることがわかる。 また、バイロクロア相についても若干生成されるが、低 温で問題ない程度にまで消滅していることがわかる。-方、図7に示す比較例においては、PbZrO,が10 00℃という高温になるまで存在するため、PZTの合 成される温度も高くなることがわかる。また、パイロク ロア相の生成についても、高温になるまで存在すること

【0042】(実施例6)本実施例は請求項5に対応す 10 るものである。まず、出発原料としてTiO,、Zr O2、Pb,O4(比表面積: 2m2/g)、Nb,O4(比 表面積:5 m²/g)、Cr2O,(比表面積:10 m²/ g) の各粉末を用意し、この出発原料のうちTiO,及 びZrO<sub>2</sub>の比表面積が表3(試料28~35)の組み 合わせとなるようにした。そして、これらの出発原料を Pb.... { (Cr./, Nb./, ) O, Ti.... Zr. .... } O』となるように秤量し、ボールミルで粉砕、混合を行 い、圧電セラミック材料とした。

出発原料として、MnCO,(比表面積:20m2/g) とNb,O,(比表面積:5 m<sup>2</sup>/g)とを含む場合、M g(OH)<sub>2</sub>(比表面積:20m<sup>2</sup>/g)とNb,O,(比表 面積:5 m<sup>2</sup>/g)とを含む場合、CoCO,(比表面 積:100m<sup>2</sup>/g)とNb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(比表面積:5m<sup>2</sup>/ g) とを含む場合、及びN b, O, (比表面積:5 m²/ g) のみを含む場合とを用意し、かつTiO、及びZr O<sub>2</sub>の比表面積が表3(試料36~58)の組み合わせ

となるようにしたものを、表3に示す組成式を満たすよ うに秤量し、ボールミルで粉砕、混合を行い、圧電セラ ミック材料とした。さらに、本実施例で作製した出発原 料にNbを含まないものを比較例とした。

【0044】上記組成の試料を複数用意し、所定の温度 まで昇温し、その温度で3分間保持して、上記試料のバ イロクロア相 (XRDで33°付近)のXRDビーク強 度とペロプスカイト相 (XRDで44°付近)のXRD ピーク強度を測定し、バイロクロア相が問題ないレベル まで消滅する温度を調べた。続いて、各圧電セラミック 材料を昇温速度2℃/minで昇温し、表3に示すバイ ロクロア相が問題ないレベルまでに消滅する温度で2時 間保持して仮焼し、粉砕して得られた仮焼粉末にバイン ダを添加して造粒した。次に、一辺が15mmで肉厚が 1 mmの正方板に成形した後、1100℃で3時間焼成 した時の焼結密度、及び電気機械結合係数(Kp)を測 定した。また、得られた焼結体に分極用電極を形成し、 60°Cの絶縁オイル中3000Vで60分間の分極処理 をして圧電セラミック素子とした。この圧電セラミック 【0043】また、Pb,O,、TiO,、ZrO,以外の 20 素子の焼結体におけるクラック発生有無を目視により観 察した。とれらの結果を表3に示す。特に、Pb,〇... TiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>以外の出発原料として、MnCO<sub>1</sub>と Nb,O.とを含む試料のうち、試料40及び試料41に ついては、各温度のパイロクロア相とペロプスカイト相 とXRDビーク強度の変化を調べ、図8及び図9に示

> [0045] [表3]

14

試料 番号	組成	出発原料の		小们加相	機成	焼結		焼結体のクラック
	MIK	Z:O,	TIO,	の消滅完了温度 (*C)	温度 (*C)	密度 (x/cm³)	結合係數 (%)	発生有無 (950°Cで仮像)
28	Pb <sub>1,00</sub> ((Cr <sub>1/3</sub> Nb <sub>2/3</sub> ) <sub>0,66</sub> Zr <sub>0,66</sub> Ti <sub>0,66</sub> )O <sub>3</sub>	1	5	1000	1100	7.83	53	(SOU C CIX SE
+29	Pb180((Cr1/3Nb2/3)089ZrassTines)O3	24	5	1050	1100	7.78	48	
30	Phian((Cri/sNb23)am2ras Tine)O3	24	21	850	1100	7.85	54	
31	Pb120((Cr1/2Nb2/3)amZr2 ar Tigas)O3	24	78	800	1100	7.87	56	
+32	Pb; 20((Cr <sub>1/3</sub> Nb <sub>2/3</sub> ) <sub>0.09</sub> Zr <sub>0.09</sub> Ti <sub>0.09</sub> )O <sub>3</sub>	38	52	1050	1100	7.79	49	-
33	Pb100((Cr1/3Nb2/3)000Zrc.erTiq.es)O5	38	111	950	1100	7.88	57	-
	Phic((Cri/3Nb2/3)amZraeTlae)O3	50	21	1050	1100	7.77	48	
	Pb, co((Cr1/3Nb2/3)000 Zr0.00 Tl0.00)O3	50	78	1050	1100	7.90	50	-
	Phie ((Mn1/3Nb2/3)010Zra4Tion)O3	1	5	950	1100	7.82	41	-
	Pb186((Mn1/2Nb2/3)280Zra48Tip41)Os		5	950	1100	7.83	41	-
38	Pb100((Mn1/3Nb2/3)010Zr04Tip11)Ox	12	21	920	1100	7.85	42	-
39	Pb.se((Mn1/3Nb2/3)010ZreseTiper)O3	12	52	900	1100	7.88	43	
+40	Phies((Mn1/3Nb3/3lateZrassTipet)Os	24	5	1150	1100	7.63	_	- 1
41	Pb160((Mn1/3Nb2/3)010Zra49Tig41)O3	24	21	1000	1100	7.85	42	-
42	Phico((Mni/sNbj/s)atoZracoTiact)Os	24	52	1000	1100	7.87	44	
*43	Phio((Mni/sNbas)asoZrasoTias)Os	32	21	1150	1100	7.85	_	*
44	Pb.ss((MnysNbys)q10ZrassTigst)Os	32	52	1050	1100	7.87	45	-
	Pb. m((Mn1/2Nb2/2)a10ZrassTias1XO2	32	, 78	960	1100	7.88	46	-
	Pb150((Mn10Nb23)010Zr045Ti041)Os	38	52	1150	1100	7.65		有
	Pb100((Mn1/3Nb2/3)010Zra40Tig41)O3	38	111	950	1100	7.69	46	無
\$	Pb, 50((Mn1/2Nb2/2) 10Zraus Tigus XO3	50	21	1150	1100	7.68		4
*49	Pb, 00((Mn1/3Nb1/3)210Zra46Tia41XO2	50	52	1150	1100	7.64	-	*
	Pb : 00 (Mn 1/3 Nb2/3) 0 10 Zra40 Tia41 XO3	50	78	1100	1100	7.67	_	有
+51	Pb1 50 (Mg1/2Nb2/2) 210 Zrant Tiges 102	24	5	950	1100	7.81	43	*
52	Ph. 80 (ME1/3Nb2/3) 010 Zra45 Tian 103	24	21	900	1100	7.83	47	無
	Pb180((Co1/3Nb2/3)930Zra4Tiget)O3		5	900	1100	7.82	49	無
	Phico((Co./3Nbg/3)quoZraceTion)O3	24	21	850	1100	7.96	53	無
+57	Pb-or(ZrassTiass)Os+0.00molNb	24	5	1000	1100	7.85	60	無
58	Pb: 05(ZrassTigus)O3+0.08molNb	24	21	950	1100	7.88	64	無
放例		24	5		1100	7.83	32	*
七枚例	Pb1,t0(ZrassTlass)Os+0.03molMn	24	21		1100	7.86	35	*

[0046]まず、試料28~58から分かるように、 ZrO,とTiO,の比表面積の割合が請求項3の範囲を 満たす試料の方が、請求項3の範囲を満たしていない試 料よりも優れた焼結密度及び電気機械結合係数が得られ ることがわかる。また、請求項3の範囲を満たしていな 30 い試料であっても、Nbを含まない比較例に比べて焼結 密度及び電気機械結合係数が優れている点がわかる。 [0047]また、Pb,O4、TiO2、ZrO2以外の 出発原料として、Cr,O,とNb,O,を含む場合(試料 28~35)は、一旦パイロクロア相が生成されても、 素体が焼結され収縮し始める温度になる前にパイロクロ ア相が消滅する性質を有しているため、焼結体にクラッ クが生じることはないが、非常に低温でパイロクロア相 が消滅している点がわかる。一方、Pb,〇,、Ti O<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>以外の出発原料として、MnCO,とNb, 40 O,を含んだ場合(試料36~50)は、バイロクロア 相が多量に生じ、素体が焼結され収縮し始める温度を超 えてもバイロクロア相が残存するため、クラックが生じ やすい。この場合、試料36~50からわかるように、 ZrO,とTiO,の比表面積の割合が請求項3の範囲を 満たす試料は、パイロクロア相が問題ないレベルまで消 滅する温度も低く、ペロブスカイト相の生成時に実質的 にバイロクロア相が存在していないため、焼結体のクラ ックも発生していないことが分かる。一方、ZrO,と

TiO<sub>2</sub>の比表面積の割合が請求項3の範囲を満たして

いない場料は、パイロクロア相が問題ないレベルにまで 清潔する温度が1100で以上と高く、圧電セラミック 素子の頻絡体にはクラックがよるきりと簡短される。 【0048】また、同じ昇温条件でXRDビーク機度の 動定した図8及び図9を見ると、ZrO、とTiOの大 表面積の割倍が請求項3の範囲を満たす試料41の方は 請求項3の範囲を満たしていない試料40よりも低い温 度でパイロクロア相が同盟ない程度にまご消滅してお り、かゴバイロクロア相とつプスカイト相が実質的に

【0049】また。それぞれの原料においても、 ZrO とTiで,の比表面積の割合が請求項3の範囲を満たす 試料の方が、 ZrO,とTiO,の比表面積の割合が請求 項3の範囲を満たしていない試料よりもバイロシロア相 が開展ないべいませて活演する温度が低く、パイロク ロア相とペロブスカイト相とが実質的に混在しないた め、高い機結南度を保つことができ、電気機械結合係数 (Kp) も高いことがわかる。

混在していないことがわかる。

【0050】(実施例7) 本実施例は請求項6および請求項7に対応するものである。組成および時代チタン粉末と酸だシルコニウム粉末との比表面類の組み合わせが実施例3の試料番号7、12の圧電セラミック材料において、粉砕前の比美面積の型輪値を算出した。次に、ボールミルによる粉砕の時間を変えて、圧電セラミック材料の比表面積を変動させ、それぞれ粉砕後の比表面積を

15

測定した。さらに、この圧電セラミック材料からチタン 酸ジルコン酸鉛を合成する過程において、ジルコン酸鉛 の生成の有無を調べ、得られた圧電セラミックの電気機 核結合係数を調べた。 なお、チタン酸ジルコン酸鉛を合 成する過程におけるジルコン酸鉛の生成の有無、および 圧電セラミックの製造方法については実施例1と同様と\* \*した。その結果を表5に示す。また、表5における試料 番号60について、実施例1、実施例2と同様に焼結密 度および電気機械結合係数を測定し、それぞれ図3. 図 4に示している。

16

[0051]

【表4】

試料 番号		電セラミッ	ク材料の装				
	出発原料の 比表面積(m²/g)		粉砕前の 比表面積	粉砕後の 比表面積	PbZrO。 の生成	焼成 温度	電気機械 対合係数
	ZrO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	$(m^2/g)$	(m²/g)		(°C)	(%)
<b>*59</b>	24	5	7	9	*	1250	33
60	24	- 5	7	10	#	1150	38
61_	24	5	7	20	-	1150	42
*62	32	21	10	12	*	1250	34
63	32	21	10	14	*	1150	40
64	32	21	10	25	- 4	1150	45

【0052】表4に示すように、圧電セラミック材料の 比表面積を粉砕前に比べ1.4倍以上となるまで粉砕し たものを用いた場合は、酸化チタン粉末と、酸化ジルコ ニウム粉末とを出発原料として同時に添加し、仮焼して も、チタン酸ジルコン酸鉛を合成する過程において、ジ ルコン酸鉛が生成していないことがわかる。また、上記 20 範囲にある圧電セラミック材料を用いて作製した圧電セ ラミックは、その焼成温度を低減でき、高い電気機械結 合係数が得られていることがわかる。なお、圧電セラミ ック材料の比表面積を粉砕前に比べ1.4倍以上となる まで粉砕したものを用いたものは、酸化チタン粉末と酸 化ジルコニウム粉末とが請求項3に記載の範囲外にあっ たとしても、チタン酸ジルコン酸鉛を合成する過程にお いて、ジルコン酸鉛が生成しない。

【0053】一方、試料番号59、62のように、酸化 チタン粉末と酸化ジルコニウム粉末とが請求項3に記載 30 の範囲外にあり、かつ圧電セラミック材料の比表面積を 粉砕前に比べ1. 4倍未満となるようにしか粉砕しなか った場合は、チタン酸ジルコン酸鉛を合成する過程にお いて、ジルコン酸鉛が生成してしまい、その焼成温度を 低減することができない。

【0054】ここで、実施例1のようにして得られる圧 電セラミックの焼成温度を変動させ、それぞれの温度で 3時間焼成したときの焼結密度および電気機械結合係数 を測定し、それぞれ図3、図4に示した。

【0055】図3、図4に示すように、実施例1、実施 40 例2、実施例7、および比較例の焼結密度、電気機械結 合係数の値と焼成温度との関係から、ジルコン酸鉛を生 成させないようにしてチタン酸ジルコン酸鉛を合成した 圧電セラミックは、チタン酸ジルコン酸鉛の合成時にジ ルコン酸鉛が生成した圧電セラミックに比べ、良好な電 気機械結合係数を実現しつつ、その焼成温度を大幅に低 減できることがわかる。

【0056】(実施例8)本実施例は請求項8に対応す る一実施例である。以下、本発明の圧電セラミック素子 は本実施例の圧電フィルタを構成する積層体の分解斜視 図、図11は本実施例の圧電フィルタの概略斜視図を示 す。まず、出発原料として、Pb,O,(比表面積:2m ²/g)、TiO,(比表面積:78m²/g)、ZrO, (比表可積:32m2/g), Cr,O,(比表而積:1 0m²/g)、Sb,O,(比表面積:10m²/g)を用 意した。この出発原料を

Pb(Zro., Tio., 1)O, +1wt%Cr, O, +2w t%Sb,O,

となるように秤量して、ボールミルで混式混合を行い、 混合粉末を得た。この混合粉末を850℃2時間で仮焼 し、得られた仮焼粉末にバインダー溶液を加えてセラミ ックスラリーとした。 このセラミックスラリーをシート 状に成形して乾燥し、セラミックグリーンシートを得 た。さらに図10のように、セラミックグリーンシート 2 a 上に所望のバターンの内部電極ペースト3 a を印刷 したものを積層して積層体1aとし、1050℃3時間 で焼成して積層焼結体とした。次に、内部電極に電気的 に接続するように、この積層焼結体の表面に分極用電板 を形成し、絶縁オイル中60°Cで1時間分極処理を行っ た。その後、積層焼結体を所定の大きさに切断して圧雷 フィルタとした。

【0057】図11に示すように、本発明の圧電フィル タ10は、圧電セラミック層2と内部電極層3とが交互 に積層されており、全体として四角柱形状の積層焼結体 1を形成している。また、それぞれの内部電極層3は積 層焼結体1の同一側面上に引き出されており、それぞれ の内部電極層3に電気的に接続するように積層焼結体の 長手方向に沿って2つの外部電極4が形成されている。 【0058】なお、本発明の圧電セラミック素子を上記 のような圧電フィルタとして適用すれば、フィルタ帯域 を大きくすることができる。

【0059】(実施例9)本実施例は請求項8に対応す る一実施例である。以下、本発明の圧電セラミック素子 として、圧電トランスについて説明する。なお、図12 として、圧電フィルタについて説明する。なお、図10 50 は本発明の圧電トランスの一部切り欠き斜視図を示す。

まず、出発原料として、Pb,O,(比表面積:2m²/ g)、TiO,(比表面積:52m²/g)、ZrO 1. (比表面積:24m²/g)、SnO,(比表面積:5 m2/g)、Sb2O,(比表面積:10m2/g)を用意 した。この出発原料を

Pb((Sn1/3Sb2/1)0.10Zr0.45Ti0.45)O, となるように秤量して、ボールミルで湿式混合を行い、 混合粉末を得た。この混合粉末を800℃2時間で仮焼 し、得られた仮焼粉末にバインダー溶液を加えてセラミ ックスラリーとした。このセラミックスラリーを長方形 10 のシート状に成形して乾燥し、セラミックグリーンシー トとした後、それぞれ対向する方向へ引き出されるよう にセラミックグリーンシートの一端側に内部電極ベース トを印刷したものを積層して積層体とし、1060℃3 時間で焼成して圧電セラミック層2と内部電極3との積 層体である積層焼結体1とした。次に、各内部電極3に 接続するように、この積層焼結体1の表面に第1外部電 極4 a 及び第2部外部電極4 b を積層焼結体1の対向で ある側面上に形成した。さらに、第1,2外部電極4 に第3外部電極4cを形成した。次に、第1.2外部電 極間で厚み方向に分極した後、第1、2外部電極4a. 4 b と第3外部電極4 c との間で長手方向に分極し、本

発明の圧電トランス20とした。 【0060】ととで、上記のようにして得られた圧電ト ランスと、比較例として、TiO<sub>2</sub>(比表面積:5 m<sup>2</sup>/ g), ZrO<sub>2</sub>(比表面積:24 m<sup>2</sup>/g)を出発原料に 用いた圧電トランスとを用意し、6 W出力時における発 熱温度を測定した。その結果、比較例の圧電トランスで 施例の圧電トランスでは発熱による温度上昇が37℃で あり、上昇温度の26%もの低減が実現できた。したが って、本発明の圧電セラミック素子を上記のような圧電 トランスとして適用すれば、発熱特性を低く抑えられる ことがわかる。

【0061】(実施例10)本実施例は請求項8に対応

する一実施例である。以下、本発明の圧電セラミック素 子として、圧電アクチュエータについて説明する。な お、図13は本発明の圧電アクチュエータの概略断面図 を示す。まず、出発原料として、Pb,O(比表面積: 40 を示すグラフ。 2 m²/g)、TiO<sub>2</sub>(比表面積:21m²/g)、Z rO<sub>2</sub>(比表面積:12m<sup>2</sup>/g)、SrCO<sub>2</sub>(比表面 積:5 m2/g)を用意した。この出発原料を Pb.,, Sr.,, (Zr.,, Ti.,,)O, となるように秤量して、ボールミルで混式混合を行い、 混合粉末を得た。この混合粉末を800℃2時間で仮焼 し、得られた仮焼粉末にバインダー溶液を加えてセラミ ックスラリーとした。 このセラミックスラリーをシート 状に成形して乾燥し、所望のバターンの内部電極ベース

時間で焼成して圧電セラミック層と内部電極とを精層し た積層焼結体とした。次に、内部電極に電気的に接続す るように、この積層焼結体の表面に分極用電極を形成 し、絶縁オイル中60℃で1時間分極処理を行った。そ の後、積層焼結体を所定の大きさに切断して圧電アクチ ュエータとした。

18

【0062】図13に示すように、本発明の圧電アクチ ユエータ30は、圧電セラミック層2と内部電極3とが 交互に積層されており、内部電極3が積層焼結体1の対 向する側面に引き出されており、それぞれ外部電極4と 電気的に接続するような構造になっている。

【0063】 ことで、上記のようにして得られた圧電ア クチュエータと、比較例として、TiO,(比表面積: 21m<sup>2</sup>/g), ZrO<sub>2</sub>(比表面積:32m<sup>2</sup>/g)を 出発原料に用いた圧電アクチュエータとを用意し、圧電 定数 d , を測定した。その結果、比較例の圧電トランス ではd, が200×10-11/mVであったのに対し、 本実施例の圧電アクチュエータではd,,が210×10 -12/mVであり、圧電定数の5%もの向上が実現でき a, 4 b が形成されたのと長手方向でみて反対側の端面 20 た。したがって、本発明の圧電セラミック素子を上記の ような圧電アクチュエータとして適用すれば、その変位 量を大きくできることがわかる。

[0064]

【発明の効果】本発明の圧電セラミックの製造方法を用 いれば、チタン酸ジルコン酸鉛を合成する過程におい て、ジルコン酸鉛の生成を抑制することができるので、 圧電セラミックの焼成温度を低減することができ、かつ 圧電セラミックの電気機械結合係数を大幅に向上させる ことができる.

は発熱による温度上昇が50℃であったのに対し、本実 30 【0065】また、本発明の圧電セラミック、ならびに これを用いた圧電セラミック素子を用いれば、圧電セラ ミック素子の諸特性を大幅に向上させることができる。 【図面の簡単な説明】

> 【図1】チタン酸ジルコン酸鉛の合成過程における、実 施例1の各化合物のXRDピーク強度比を示すグラフ。 【図2】チタン酸ジルコン酸鉛の合成過程における、比 較例の各化合物のXRDビーク強度比を示すグラフ。 【図3】実施例1、実施例2、実施例7および比較例に おける、圧電セラミックの焼成温度と焼結密度との関係

【図4】実施例1、実施例2、実施例7および比較例に おける、圧電セラミックの焼成温度と電気機械結合係数 との関係を示すグラフ。

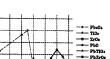
【図5】チタン酸ジルコン酸鉛の合成過程における 酸 化チタン粉末および酸化ジルコニウム粉末の比表面積と ジルコン酸鉛の生成との関係を示すグラフ。

【図6】酸化ニオブ粉末を添加したチタン酸ジルコン酸 鉛の合成過程における、実施例5の各化合物のXRDビ ーク強度比を示すグラフ。

トを印刷したものを積層して積層体とし、1020℃3 50 【図7】酸化ニオブ粉末を添加したチタン酸ジルコン酸

20 鉛の合成過程における、実施例5の比較例の各化合物の \*【符号の説明】 XRDビーク強度比を示すグラフ。 1 積層焼結体 【図8】実施例6における、試料番号40のパイロクロ 1 a 積層体 ア相及びベロブスカイト相のXRDビーク強度と仮焼温 2 圧電セラミック層 度との関係を示すガラフ. 2 a セラミックグリーンシート 【図9】実施例6における、試料番号41のパイロクロ 3 内部電極 ア相及びペロブスカイト相のXRDビーク強度と仮焼温 3 a 内部電極ペースト 度との関係を示すグラフ。 4 外部電極 【図10】実施例8の圧電フィルタを構成する積層体を 4 a 第1外部電極 示す分解斜視図 4 h 第2外部電極 【図11】実施例8の圧電フィルタを示す概略斜視図 4 c 第3外部電極 【図12】実施例9の圧電トランスを示す一部切り欠き 1.0 圧電フィルタ 斜相図 20 圧電トランス 【図13】実施例10の圧電アクチュエータを示す概略 30 圧電アクチュエータ

- Pb(Zr.T1)O

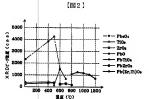


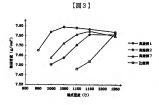
【図1】

4000

3000

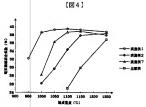
2000





200 400 600 800 1000 1200

温度(で)



[図13]

